

**КТ819**

кремниевый биполярный  
эпитаксиально-планарный  
п-р-п транзистор

**Назначение**

Транзистор п-р-п кремниевый эпитаксиально-планарный в пластмассовом корпусе. Предназначен для использования в ключевых и линейных схемах; другой радиоэлектронной аппаратуре, изготавливаемой для народного хозяйства

**Номер технических условий**

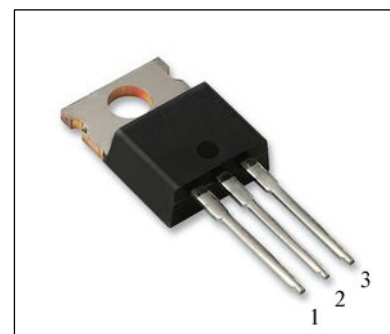
- аАО.336.189 ТУ / 02

**Особенности**

- диапазон рабочих температур от - 45 до + 100 °С

**Корпусное исполнение**

- пластмассовый корпус КТ-28 (ТО-220)

**Назначение выводов**

Вывод	Назначение
№1	Эмиттер
№2	Коллектор
№3	База

**Таблица 1. Основные электрические параметры КТ819 при  $T_{\text{окр. среды}} = + 25 \text{ }^{\circ}\text{C}$** 

Параметры	Обозначение	Ед. изм.	Режимы измерения	Min	Max
Обратный ток коллектора	$I_{кбо}$	мА	$U_{кб}=40\text{В}$		1
Статический коэффициент передачи тока КТ819А, В КТ819Б КТ819Г	$h_{21э}$		$U_{кб} = 5 \text{ В}, I_{э} = 5 \text{ А}$	15 20 12	
Граничное напряжение КТ819А КТ819Б КТ819В КТ819Г	$U_{кэо гр}$	В	$I_{э} = 0,3 \text{ А},$ $t_{и} = 270 \div 330 \text{ мкс}$	25 40 60 80	
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер	$U_{кэ нас}$	В	$I_{к}=5\text{А}, I_{б}=0,5\text{А}$		2

**Таблица 2. Значения предельно допустимых электрических режимов эксплуатации КТ819**

Параметры	Обознач.	Ед. изм.	Значение
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{эб} \leq 1 \text{ кОм}$ КТ819А КТ819Б КТ819В КТ819Г	$U_{кэ max}$	В	40 50 70 100
Напряжение эмиттер-база	$U_{эб max}$	В	5
Постоянный ток коллектора	$I_{к max}$	А	10
Импульсный ток коллектора $t_{и} \leq 10 \text{ мс}, Q \geq 100$	$I_{ки max}$	А	15
Максимально допустимый постоянный ток базы	$I_{б max}$	А	3
Импульсный ток базы $t_{и} \leq 10 \text{ мс}, Q \geq 100$	$I_{би max}$	А	5
Рассеиваемая мощность при $T_{корп.} \leq 25 \text{ }^{\circ}\text{C}$	$P_{к max}$	Вт	60